



(公社)日本表面科学会 第74回表面科学研究会
平成24年度中部表面科学シンポジウム

「パワーデバイス用ワイドバンドギャップ半導体の表面・界面の制御」

主催 日本表面科学会

協賛（依頼中を含む）： 応用物理学会東海支部、応用物理学会先進パワー半導体研究会、
日本真空学会東海支部

日本表面科学会では、「パワーデバイス用ワイドギャップ半導体の表面・界面の制御」と題して研究会・シンポジウムを開催することにいたしました。パワーデバイスは、太陽光発電、電気自動車、電車などにおいて電力を効率良く使用するために性能向上が求められています。SiC、GaNといったワイドバンドギャップ半導体はパワーデバイスに適した物性を持っていることから次世代パワーデバイス用材料として注目を集めています。ワイドギャップ半導体は硬くて脆い上に極性材料であるため、シリコン以上に表面・界面の制御は難しく、表面科学のアプローチは重要です。本研究会・シンポジウムではワイドバンドギャップ半導体の表面・界面の最新研究について講師の先生方にご講演いただく予定です。皆様のご参加をお待ちしています。

1. 日時 2013年1月26日（土） 13:00-17:30
2. 場所 名古屋大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー ベンチャーホール（3F）
3. プログラム
13:00-13:10
開会あいさつ 吉村雅満（中部支部長）、石川由加里（企画者代表）
(1) 13:10-14:10
「SiC 表面形態がデバイスの電気的特性に及ぼす影響」
渡辺行彦（㈱豊田中央研究所）
(2) 14:10-15:10
「CAREによるワイドバンドギャップ材料のナノレベル平坦化メカニズム」
佐野 泰久（大阪大学）
(3) 15:20-16:20
「高硬度、脆性ワイドギャップ半導体の表面加工」
堀田和利（㈱フジミ・インコーポレーテッド）
(4) 16:20-17:20
「GaN パワーデバイスにおける異種接合界面の制御」
橋詰 保（北海道大学）
17:20-17:30
閉会あいさつ 村上健司（中部支部副支部長）

4. 参加費（テキスト代含む、消費税含む、当日会場にて受付）
 会員（協賛学会員を含む）2000円、学生1000円、一般4000円
 閉会後の懇親会参加費4000円（参加希望者は講演参加申込時にご連絡ください）

5. 申込方法

参加定員100名

ウェブサイト (<http://www.sssj.org/>) から直接申し込むか、e-mail (shomu@sssj.org)、
 FAX または官製はがきに次の項目を記入し日本表面科学会までお申込ください。

- (1) 氏名（ふりがな）、(2) 所属、(3) 連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）
 (4) 参加区分（会員（協賛学会員を含む）、学生、一般）

締め切り：2013年1月19日（土）

6. 問い合わせ先

山方 啓 豊田工業大学 物質工学分野

〒468-8511 愛知県名古屋市天白区久方2-12-1

FAX ; 052-809-1828, e-mail ; yamakata@toyota-ti.ac.jp

* お申込に際しご記載いただきましたメールアドレスは、表面科学会が主催する本件以外のセミナー・講演会などのご案内にも使用させていただく場合がございます。ご案内が不要な方はお手数ですがその旨お申し出ください。

7. 会場案内

名古屋大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー <http://www.vbl.nagoya-u.ac.jp/>

〒464-8601 名古屋市千種区不老町 VBL事務室 TEL: 052-789-5447, FAX: 052-789-5448

e-mail : office@vbl.nagoya-u.ac.jp

名古屋市営地下鉄「名古屋大学」駅3番出口から徒歩3分



公益社団法人 日本表面科学会
 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-40-13 本郷3-ホ113ヨ1 402
 電話 03 (3812) 0266 FAX. 03 (3812) 2897
 E-mail: shomu@sssj.org
 URL: <http://www.sssj.org>